

а 2007 0230

Изобретение относится к оптоэлектронике, а именно, к способу получения фоточувствительного материала на основе аморфного халькогенидного полупроводника $As_2(S_xSe_{1-x})_3$, который может быть использован в качестве среды для записи оптических и голографических изображений, оптических сенсоров, в микролитографии и др.

Способ заключается в том, что отдельно растворяются As_2S_3 и As_2Se_3 в моноэтанолаmine или в этилендиаmine при температуре 20...40°C, затем смеси охлаждаются до комнатной температуры и смешиваются в отношении, определяемом значением x , после чего смесь наносится на подложку и высушивается на воздухе при температуре до 40°C, в течение 2 часов.

П. формулы: 1

Фиг.: 2